



第64回 半導体・集積回路技術シンポジウム

2003年 6月5日(木)・6日(金)

大阪国際交流センター

(大阪市天王寺区上本町8-2-6 TEL 06-6772-5931 URL: http://www.ih-osaka.or.jp)

第1日

6月5日(木) 9:45~17:00

- <9:45> 開会の挨拶 東京工業大学: 小田俊理
<9:50> 第63回シンポジウムアワード表彰式
<10:00~10:50>
1. 招待講演 高誘電率ゲート絶縁膜を用いたMISFETの移動度低下機構
日立製作所: 斎藤慎一
<10:50~11:15>
2. リモートプラズマ酸化により形成したHfO₂膜の電気的特性
松下電器産業半導体社¹, 日立国際電気²: 山本和彦¹, 林重徳¹, 原田佳尚¹, 久保田正文¹, 丹羽正昭¹, 浅井優幸², 堀井貞義²
<11:15~12:05>
3. 招待講演 Scaling Hf-based high-k gate stacks to(sub)1.0nm EOT: a status update
IMEC: Stefan De Gendt
<12:05~13:00> 昼食
<13:00~13:50>
4. 招待講演 The emerging new memories: their characteristics and application.
Samsung Electronics: Hogsik Jeong
<13:50~14:15>
5. 強誘電体を用いた不揮発性ロジック
ローム: 中村孝, 藤森敬和, 高須秀視
<14:15~14:40>
6. 強誘電体BiFeO₃薄膜の作製とその評価
大阪大学: 尹貴永, 野田実, 奥山雅則
<14:40~15:05>
7. Flash CVD 薄膜形成技術
WACOM 電創: 矢元久良, 庄司正文, 阿久戸和哉, 小林等, 綿貫宏, 長岡健, 深川満, 酒井諒一
<15:05~15:20> 休憩
<15:20~16:10>
8. 招待講演 MONOS不揮発性メモリ技術の開発
ルネサステクノロジ: 南真一
<16:10~16:35>
9. MONOS不揮発性メモリに使われるシリコン窒化膜のESR評価
香川大学¹, ソニー²: 穴戸謙¹, 神垣良昭¹, 藤原一郎²
<16:35~17:00>
10. シリコン高周波ICのための厚膜酸化層形成プロセス
デンソー: 鶴田和弘, 柴田貴行
<17:00~18:30> 懇親会

第2日

6月6日(金) 9:30~16:40

- <9:30~10:20>
11. 招待講演 65nm ノード Low-k 材料プロセス開発の現状
半導体先端テクノロジーズ: 小林伸好
<10:20~10:45>
12. 高強度有機低誘電率層間絶縁膜材料の設計と開発
超先端電子技術開発機構: 青井信雄, 福田琢也, 柳沢寛
<10:45~11:10>
13. ダイヤモンドナノ粒子を用いた低誘電率ポーラスダイヤモンド膜の形成
広島大学大学院¹, 科学技術振興事業団², 大研化学工業³: 坂上弘之¹, 富本博之², 石川佐千子³, 新宮原正三¹, 高萩隆行¹
<11:10~12:00>
14. 招待講演 Cu/Low-k 多層配線構造の STRESS ENGINEERING
東芝 セミコンダクター社: 蓮沼正彦
<12:00~13:00> 昼食
<13:00~13:50>
15. 招待講演 Pd 触媒なし無電解銅めっき配線技術
広島大学: 新宮原正三
<13:50~14:15>
16. 薄シード層上でのCu電解メッキ膜厚の面内均一性の向上
荏原製作所: 鈴木秀直, 野村和史, 井出邦仁, 神田裕之, 三島浩二
<14:15~15:05>
17. 招待講演 Cu配線およびバリア材の微細構造と信頼性
京都大学大学院: 守山実希
<15:05~15:20> 休憩
<15:20~15:45>
18. 塩化金属還元法によるCuおよびTa成膜技術
三菱重工業: 坂本仁志, 小椋謙, 大庭義行, 八幡直樹
<15:45~16:10>
19. 90nm ノードCu/Low-k配線の信頼性改善
ルネサステクノロジ¹, 松下電器産業², 松下半導体エンジニアリング³: 橋本圭司¹, 松本晋², 石井敦司¹, 富田和朗¹, 西岡康隆¹, 関口満², 岩崎晃久³, 磯野俊介², 佐竹哲郎², 岡崎玄², 藤沢雅彦¹, 松本雅弘¹, 山本茂久¹, 松浦正純¹
<16:10~16:35>
20. SiLK層間絶縁膜を用いたCu配線の信頼性
富士通VLSI¹, 富士通²: 佐藤元伸¹, 森博子², 松岡由博¹, 松山英也², 庄野健²
<16:35> 閉会の挨拶 松下電器産業: 久保田正文

参加申込締切(予約) 5月30日(金)迄に申込書式に従い費用を添えて(現金書留または銀行振込・みずほ銀行大岡山支店 普通預金口座1926159 電子材料委員会小田俊理カシュリ宛)お申込み下さい。
銀行振込の際も氏名、勤務先、連絡先をご連絡下さい。

参加登録費(講演論文集1部、懇親会費を含む)

予約 会員 20,000円 会員外 22,000円 大学関係 5,000円 (1日のみ 会員 14,000円 会員外 15,000円)

当日 会員 22,000円 会員外 24,000円 大学関係 6,000円 (1日のみ 会員 15,000円 会員外 16,000円)

講演論文集のみ希望の場合、1部6,000円でお分け致します。

参加申込、論文集申込先 〒102-0074東京都千代田区九段南4-8-30アルス市ヶ谷202

電気化学会電子材料委員会(TEL: 03-3234-4213, FAX: 03-3234-3599)

電気化学会電子材料委員会 主催

応用物理学会、高分子学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、日本印刷学会、日本化学会、日本金属学会、日本セラミックス協会、日本写真学会、日本表面科学会、日本真空協会、ILK/IC実装学会 協賛